EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

: 06151520

PUBLICATION DATE

31-05-94

APPLICATION DATE

06-11-92

APPLICATION NUMBER

04321347

APPLICANT : SONY CORP:

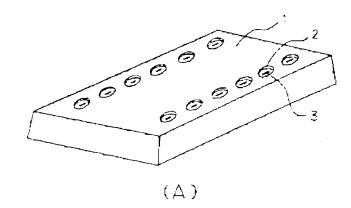
INVENTOR: ITO HITOSHI;

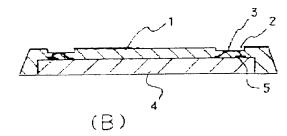
INT.CL.

H01L 21/60 H01L 21/56 H01L 23/28

TITLE

SEMICONDUCTOR DEVICE





ABSTRACT :

PURPOSE: To furnish a resin-sealed type semiconductor device which enables attainment of a high-density package and reduction of the cost and is easy to handle, by a small-sized, thin-type and compact construction.

CONSTITUTION: In a semiconductor device made up of a semiconductor chip 4 having a pad electrode 5, a wire 3 bonded to the pad electrode and a molding material 1 covering the surface of the pad electrode and sealing a semiconductor chip, a part of the wire 3 is exposed on the surface of the molding material 1.

COPYRIGHT: (C)1994, JPO& Japio

		•

(19)日本医特許庁 (JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出額公開番号

特開平6-151520

(43) 公開日 平成6年(1994) 5円31日

(S) Int.CL*	識別記号	守内整班番号	11	技術表示箇所
HOIL 21/60	3 2 1 Z	6918 - 4M		
21/56	T	8617 = 4 M		
23./28	A	8617 - 4M		
	Z	8017 - 4M		

審査請求 未請求 請求項の数5(全 4 頁)

(21)出願番号

特顯平4-321347

(71)出額人 (000002185

(22)出始日

平成4年(1992)11月6日

ソニー株式会社 東京都品川区北品川6丁目7番35号

(72)発明者 伊藤 仁

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ

一株式会社内

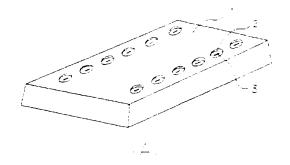
(74)代理人 并理士 高橋 光男

(54)【発明の名称】 半導体装置

(57]【要約】

【目的】 小型薄型でコンパクトな構成として高密度実 装を可能とし、コストの低減を図るとともに取扱いの容 易な樹脂封止型半導体装置を提供する。

【構成】 「付け下電極きを有する半導体干…です」、武 パッド電極にポンディングされたロイヤ3と、該バッド 電極面を覆って前記半導体チップを封止するモールド材 1 とからなる半導体装置において、前記ワイナ3の一部 が前記モーリド村上の表面に蘇出している。





【特許請求の範囲】

【請求項1】 バッド電極を有する半導体チップと、該 バッド電板にポンディングされたワイヤと、該バッド電 梅面を覆って前記半導体チャブを封止するモールド材と からなる半導体装置において、前記ワイヤの一部が前記 モールド材の表面に露出していることを特徴とする半導 仏装置。

【請求項2】 前記サイヤの一端が前記パッド電極上に ボンディンプされ、他端は該パッド電極近傍の分離した 位置の半導体チップ上にポンディングされたことを特徴 10 らに、外部リードが樹脂モールド体2.7から突出して引 とする請求項1に記載の半導体装置。

【請求項3】 前記サイヤの一端が前記パッド電極上に ボンディングされるとともに他端が同じバッド電極上に ポンディングされ、飲パッド電機上にワイヤのループを 形成したことを特徴とする請求項1に記載の半導体装

【請水項4】 一寸の型材間に形式されたキャビディ内 に半導体チャブを配置し、許キャピティ内にモールド材 を充填して該半導体チップを封止する半導体装置の成形 ガ法において、前記型材が前記パッド電極上に突出して 20 -いる前記ワイヤに当接してこれをバッド電極面側に押田 した状態で前記キャピティ内にモールド材を充填するこ とを特徴とする請求項1 に記載が半導体装置の成形方

【謙木項 6】 プリント基板のバターン形成面側に対し 前記パッド電極面側を対向させ、試パッド電極上に露出 する前記ロイヤを翻プリント基板のバターンに接合して 該プリント基板上に搭載したことを特徴とする請求項1 に記載で半導体装置。

【発明に詳細な説明】

[0:01]

【産業上の利用分野】本発明は半導体装置に関し、特に 樹脂封止型半導体装置の電極取り出し構造に関するもの てある。

[0002]

【従来の技術】樹脂封止型半導体装置は、表面にバッド 電極を有する半導体チップを樹脂モールド内に埋設して 形成される。従来の樹脂封止型半導体装置の構造を図5 に示す。斗導体干シブ20は、工ポキシ系の接着剤21 固定される。リードフレームはダイバッド22の周囲に 内部リード23およびこれに連続する外部リード24を 有し、内部リード2.3が金等の金属細線からなるポンデ ィンプロイヤ26を介して半導体デップ20上の対応す るパッド電極25と接続される。このようにしてリード フレーニ上に搭載した半導体チップをワイヤボンディン ゲした状態で、金型を用いて樹脂モールド体27を形成 こ半導位チップの樹脂封止を行う。これにより、半導体。 装置 マッケージ が形成される。

[0 | 0 3]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前記従 来の樹脂封正型半導体装置においては、外部との電気的 接続をリードフレームの外部リードに4を介して行わた め、ユードフレーム分の厚さおよび占有面積とエイニー ドフレームを覆う部分の樹脂モールド体27の厚さ、面 積が増え、半導体装置全体が大きくなって、コンパクト で高密度実装可能な半導体装置の実現が図られなかっ た。また、構成材料や組立工数が多くなり、製造作業が 面倒となってコストも上昇するという問題があった。さ 出されているため、取扱い上のミス等により外部リード 24が変形するまそれがあり、この場合外部リードがで リント基板上の所定のランドパタート上に接合されず、 実装不良を起こすという問題があった。

【0004】本発明は上記従来技術の矢点に鑑みなされ たものであって、小型蒸型でコンパケトな構成として高 密度実装を可能とし、コストの低減を図るとともに取扱 いの容易な衝脂封止型半導体装置の提供を目的とする。 [0005]

【課題を解決するための手段】前記目的を達成するた め、本発明では、パッド電極を有する半導体チャプと、 該バード電極にポンディングされたコイヤと 該バッド 電極面を覆って前記半導体チップを封止するモールト村 (樹脂) とからなる半導体装置におって、前記ワイヤの 一部が前記モールド材の表面に露出していることを特徴 とする半導体装置を提供する。

【0006】好ましい実施例においては、前記ワイヤの 一端が前記パッド電極上にポンディングされ、他端は許 バッド電極近傍の分離した位置の半導体チップ上にポン 30 ディングされている。別の好ましい実施例においては、 前記ロイヤの一端が前記パッド電極上にボンディングさ れるとともに他端が同じハッド電極上にポンディングさ れ、該パッド電極上にロイヤのループを形成している。 【0007】本発明に係る樹脂封止型半導体装置は以下

のようにモールド成形される。即ち、一対の型材(金 型)間に形成されたキャピティ内に半導体テップを配置 し、該中キビディ内にモールド材(樹脂)を充填して割 半導体子:ブを封止する半導体装置の成形方法におい て、前記型材が前記パット電極上に突出している前記し を介してリードフレーム中央のダイバッド2.2上に搭載 40 イヤに回接してこれをバッド電極面側に押圧した状態で 前記キャピティ内にモールド材を充填する。本発明に任 る樹脂封止型半導体装置は、プリント基板のバターンサ 成面側に対し前記ペッド電極面側を対向させ、該バット 電極上に露出する前記ワイヤを該ブリント基板のバター ンに接合して該プリント基板上に搭載される。

100081

【作用】半導体チップのハッド電極にフィヤをボンディ ングし、このワイヤの一部をモールド成形体の表面に蘇 出させる。この露出したワイヤを外部との接続用電極と あっても、これにより、リードフレームは不要になる。

[0009]

【実施例】図1は本発明の実施例に係る樹脂封止型半導 Aは他を示す。 (A) は斜視図、 (B) は鞭断面図であ 」の主導体接近は、体側が樹脂モールド体1で覆む。 れ、この樹脂モールト体上に門みこが形成され、各門み よ内に金等の金属細線からなるワイヤ3が露出する。樹 脂封止された半導体チップ4は表面に複数のパッド電極 そを有し、各パッド電極をに前記ロイヤ3がポンディン がされる。樹脂モールド体 1 はこのバッド電極 5 を模っ のようにこの樹脂モールド体1の表面に露出する。

【0.0.1.0】図2は半導体チップ4にポンディングされ るフェヤ3の詳細を示す。ワイヤ3は(A)に示すよう に、半導体チップ4の上面両側線に沿って2列に設けら れた複数のペッド電極をの各々に対し接合される。この ワイヤ3は、(B) に示すように、その一端をパッド電 横る上にボンディングと他端をこのパッド電極もの近傍 で分離した位置の半導体チップ4上にポンディングして もよいし、あるいは(C)に示すように、一端をバッド 電極ミ上にポンディングし、他端を同じパッド電極ミ上 20 型化が図られ高密度実装が可能になる。また部品点数や にポンディングして電極上にループを形成させてもよ

【りじ11】このようにロイヤ3をバッド電極5上にボ ンディングした半導体チップ4の樹脂封止方法を図るに 示す。(A) は封止前の状態、(B) は封止工程の状態 を示す。半導体チップ4は、一対の上金型6および下金 型7の間に形成されたキャピティ8内に配置される。1 3は両金型6、7が圧接および分離するバーティングラ インを示す。上金型6には、各ワイヤ3の位置に対応し σ上端に当接してワイヤミを電極5側に押圧変形させた **せ態でこのキャビテ:8内に樹脂(図示しない)を完填** して半導体モップ4を樹脂封止する。これにより、上金 型のの突出部のに当接した部分のロイナるが、キャビデ とうから取り出した後のモールト武形体の表面に露出す

【0012】画金型6.7を圧接したときに、上金型6 の突出部9か確実にウイヤ3に当接してこれを押圧変形 させるように、突出部9の高さおよび半導体チップ4の 厚さを考慮して予めたイナ3に高さを適当に設定しても、ポームチャブ、5:パッド電極、

【0013】図4は本発明に係る半導体装置の実装状態 を示す。プリント基板10上にランドバターン11が形 成されている。こいランドバターン形成面似に対し、半 連体装置のワイナ露出面側を対向させて、露出したワイ ヤビランドパターン11とを導電機脂10を介して接台 し両者を電気的に接続するとともに、半導体装置をプリ シト基板10上に搭載固定する。

【0.0.1.4】なお。上記実施例では、樹脂モールド体1 丁丰邁体チェブ4を封正する。ワイヤ3の上端部が前述 10 の凹所(凹み)2内にワイヤ3を露出させるように構成 したが、これに限らず目的に応じて、モールド体に突出 部を形成してこの突出部にワイヤを露出させてもよい し、あるいは平坦部にワイヤを露出させてもよい。

> 【発明の効果】以上説明したように、本発明において は、半導体モップのバッド電板にポンディングしたワイ ヤをモールド体表面に露出させてこれを外部との接続用 電極として用いるため、従来のようなリードフレームが 不要になる。これにより、半導体装置の小型化および薄 材料が少なくなりコストの低減が達成されるとともに製 造組立が容易に行われ、さらにリードが突出しないため 取扱いが容易になりまたリード変形に基づく接合不良等

【因面の簡単な説明】

がなくなり歩留りの向上が図られる。

[0015]

【図1】 (A) (B) はそれぞれ本発明の実施例に係 る半導体装置の斜視図および縦断面図である。

【図2】 (A) (B) (C) はそれぞれ本発明の実施 例に係る半導体チップの斜視図、ロイヤのポンディング て突出部9が設けられている。この突出部9がワイヤ3~30~構造の一例の側面図およびワイヤのポンディング構造の 別の例の側面区である。

> 【図3】 (A) (B) はそれぞれ本発明の実施例に折 も半導体装置の封止前の断面図および金剛を用いた樹脂 封上に和状態の断面図である。

> ([14] 本発明の実施例に係る生導体装置の実装状態 の断面似である。

【図5】 従来の半導体装置の断面図である。

【符号の説明】

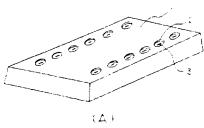
1:樹脂モーリト体、2:匹み、3:27で、4:半導

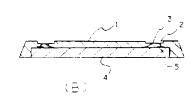


(4)

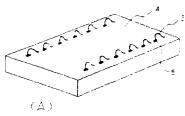
特開平6-151520

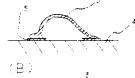


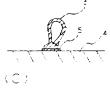




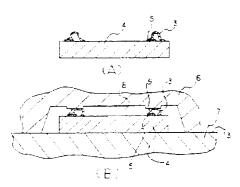
[M2]







[12]3]



[図5]

